

拒絶引用Soo 1138cNoo

3

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-224777

(43) 公開日 平成11年(1999) 8月17日

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>H 0 5 B 33/10  
33/14

識別記号

F I

H 0 5 B 33/10  
33/14

Z

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平10-27495

(22) 出願日 平成10年(1998) 2月9日

(71) 出願人 000005234

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

(72) 発明者 漆谷 多二男

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

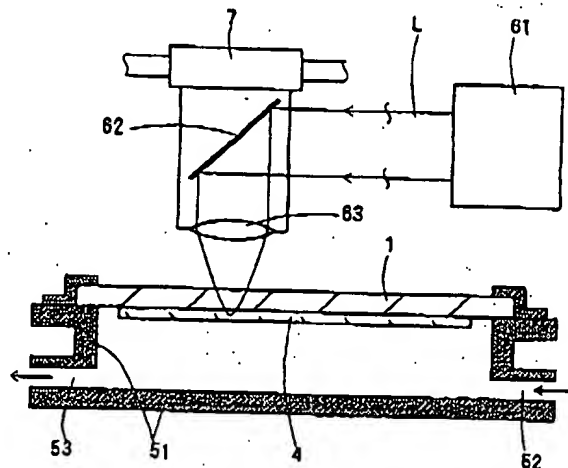
(74) 代理人 弁理士 篠部 正治

(54) 【発明の名称】 薄膜エレクトロルミネッセンス素子とその製造方法および製造装置

(57) 【要約】

【課題】 基板の変形を生じずに、基板の変形限界以上の温度の熱処理に相当する発光輝度のアルカリ土類金属硫化物E-L発光層を有する薄膜E-L素子、製造方法を提供する。

【解決手段】 ノンアルカリガラス基板1上に順に第一の電極層、第一の絶縁層、アルカリ土類金属硫化物からなる発光層4、第二の絶縁層、および第二の電極層が形成されてなる薄膜エレクトロルミネッセンス素子の製造方法において、前記発光層にレーザー光を照射して、発光層の発光輝度を向上させる。図は本発明の輝度向上に用いた製造装置を示す。レーザー光は集光光学系63によって発光層に集光され、また走査装置7によって走査される。



Best Available Copy